

プレーナ形シリコンPINダイオード  
可変抵抗減衰器用

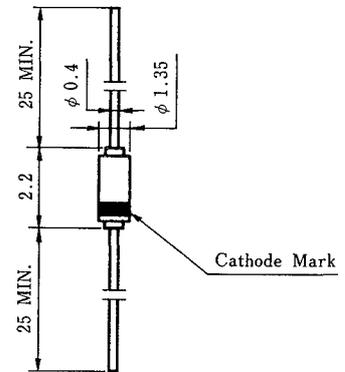
Silicon PIN Diode  
VHF/UHF RF Attenuating and Switching

特長/FEATURES

- 直流順バイアス電流により定まる直線性の非常に良い、高周波帯の可変抵抗として働きます。
- ケース容量の小さい、DHD構造（ガラス本体の長さ  $l$ ; 2.2 mm, 径  $\phi$ ; 1.35 mm）の採用。
- 小形実装に最適です。

外形図/PACKAGE DIMENSIONS

(Unit: mm)



絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項目	略号	定格	単位
逆電圧	$V_R$	30	V
順電流	$I_F$	50	mA
せん頭順電流	$I_{FM}$	150	mA
電力損失	$P_D$	250	mW
保存温度	$T_{stg}$	-65 ~ +175	$^\circ\text{C}$
接合部温度	$T_j$	175	$^\circ\text{C}$

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
順電圧	$V_F$	$I_F = 50 \text{ mA}$		0.95	1.2	V
逆電圧	$V_R$	$I_R = 10 \mu\text{A}$	30			V
端子間容量	$C_t$	$V_R = 20 \text{ V}, f = 1.0 \text{ MHz}$		0.4	0.6	pF
高周波直列抵抗	$r_{ds}$	$f = 100 \text{ MHz}, I_F = 10 \text{ mA}$	6.0	10	15	$\Omega$
高周波並列抵抗	$r_{dp}$	$f = 100 \text{ MHz}, I_F = 10 \mu\text{A}$	1.0	4.0	6.0	k $\Omega$

